

Əmirova Səbinə İkrəm qızı



Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,

Fiziki elektronika kafedrasının müəllimi

İş telefonu: 99412-439-73-73

E-mail: sbn.amirova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

05 noyabr 1977-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub, ali təhsilli fizik, fizika müəllimidir. Ailəlidir, 2 övladı var. Ləzgidir, Bakı şəhərində yaşayır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1994-1998 Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, «Fiziki elektronika» ixtisası üzrə bakalavr pilləsi

1998-2000 Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsində «Plazma fizikası» üzrə magistr pilləsi

2008 ildə “ $Cd_{1-x}Zn_xS_{1-y}Se_y$ tipli bərk məhlullarının nazik təbəqələri və onların əsasında yaradılmış strukturlarda elektron prosesləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-2004 Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Fiziki elektronika kafedrasında baş laborant

2004 ildən Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Fiziki elektronika kafedrasının müəllimi

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR APARIR

Ümumi fizika, Fiziki elektronikanın əsasları, elektron cihazlarının fizikası.

30-dan artıq elmi əsərin müəllifidir

HƏYATA KEÇİRDİYİ TƏCRÜBƏLƏR VƏ ELMİ YENİLİKLƏRİ HAQQINDA

$A^{II}B^{VI}$ tip yarımkəçiricilərin bərk məhlullarının nazik təbəqələrinin və onların əsasında müxtəlif kontakt strukturlarının hazırlanması və elektron xassələrinin tədqiqi

TƏDQIQAT SAHƏSİ

Nazik təbəqələrdə və onların əsasında hazırlanmış kontakt strukturlarında elektron proseslərinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2006, 2007, 2008 Materialşünaslıq üzrə Beynəlxalq Simpozium, Strasburq,

2006,2012,2014 "Fotoelektronika və gecə görmə cihazları" Beynəlxalq Elmi-texniki konfransı, Moskva;

2006 "Bərk cisim elektronika və mikroelektronikanın aktual problemləri" Beynəlxalq Elmi-texniki konfransı, Taqanroq;

2006 "Opto-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosistemlər" Beynəlxalq Konfransı, Ulyanovsk;

2013 "Mikroelektronika çeviriciləri və onların əsasında qurğular" Yeddinci Beynəlxalq Elmi-Texniki Konfransı. Sumqayıt

2013 "Fizikanın aktual problemləri" Beynəlxalq elmi konfransı ,Bakı,

2015. Fizikanın fundamental və tətbiqi məsələləri,Дашкәнд.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Elektrokimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış p-Si/Cd_{1-x}Zn_xS heteroqəçidinin fotoelektrik xassələri. Thin Solid Films. 2005. V.48, pp.388-391

2. Elektrokimyəvi üsulla alınmış p-Si/Cd_{1-x}Zn_xS_{1-y}Se_y heteroqəçidləri əsasında günəş elementlərinin tədqiqi. Thin Solid Films. 2006, v.511-512, p.140-142

3. Mo/CdS_{1-x}Se_x əsasında hazırlanmış İQ fotoqəbuledicilərinin parametr və xarakteristikalarının stabillik dərəcəsinin artırılması haqqında. Прикладная физика, 2006, № 5, с.82-86.

4. Elektrokimyəvi çökdürülmüş $\text{SnO}_2/\text{Cd}_{0.4}\text{Zn}_{0.6}\text{S}/\text{CdTe}$ günəş elementlərinin elektrik və fotoelektrik xassələri. Физика и техника полупроводников, 2006, Т.40, в.12, с.1476-1478
5. $\text{In}_2\text{O}_3/\text{Cd}_{0.4}\text{Zn}_{0.6}\text{S}_{0.9}\text{Se}_{0.1}/\text{CdTe}$ heteroqəçidləri əsasında günəş elementlərinin termik işlənməsi i. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2007, v.1, № 9, p.480-483
6. İndium monoselenidi kristallarında temperatur un və nadir torpaq elementləri ilə aşkarlanmanın sərbəst yükdaşıyıcılarının yüüklüünə təsiri. // Физика и техника полупроводников, 2013, Т.47, № 8, с. 1009-1013
7. Qallium monoselenidi kristallarının elektrofiziki parametrlərinə temperatur və nadir torpaq elementləri ilə aşkarlanmanın təsiri.// Неорганические материалы, 2014, Т.50, № 4, с. 323- 367
8. İndium monoselenidi kristallarında sərbəst yükdaşıyıcılarının yüüklüünə işıqın təsiri.// Физика и техника полупроводников, 2014, Т.48, № 8. С. 1009-1013.
9. Qalium monoselenidi əsasında infraqırmızı işıq qəbulediciləri.// Прикладная физика, 2015, № 5. С 67-71.
10. n-InSe monokristallarının elektrofiziki xassələrinin xüsusiyyətlərin haqqında.// Физика и техника полупроводников , 2016, Т.50, № 1, с. 35-38.